



**Noah Consulting Limited** 

# 表D1-1 参考としたデバイス構造

層	厚さ d (nm)	屈折率 n	
p-GaN (contact)	30	2.54	12
p-Al0.14Ga0.86N/GaN SL (cladding)	600	2.48	
p-GaN (waveguide)	100	2.54	
p-Al0.2Ga0.8N (stopper)	20	2.23	
n-In0.02Ga0.98N (barrier)	10	2.61	
n-In0.15Ga0.85N (quantum well)	4	3.0	
n-In0.02Ga0.98N (barrier)	10	2.61	
n-In0.15Ga0.85N (quantum well)	4	3.0	
n-In0.02Ga0.98N (barrier)	10	2.61	
n-GaN (waveguide)	100	2.54	
n-Al0.14Ga0.86N/GaN SL (cladding)	1200	2.48	
n-In0.1Ga0.9N (compliance)	100	2.98	1
n-GaN (substrate)	3000	2.54	

J. Piprek, "Semiconductor Optoelectronic Devices-Introduction to Physics and Simulation," Chapter 9, Academic Press, California, 2003.のTable 9.4より関連部分を記した。

### APSSを起動する。新規作成の場合には、図D1-1に示すように、Fileから NewProject Waveguideを選択する。

APSS [APSS 2	3] - TRIAL		
File Edit View	Task Result We	dow System Help	
New Project + Copen_ Save Save At.	Haterials	(2) * C * (2) # C = C = C * (2) * (2) * C * (2)	
Inport Export			
Print Setup.			
Logout Exit			
Projects Decise Manager Labor			
Project Manager, Holds	all open projects.		
1			-

#### 図D1-1.モード解析の最初のステップ

すると、図D1-2のウインドウが開く。ここでは、Nameの下のテキストボックスにプロ ジェクト名を定義する。ここでは、"W\_InGaN-LD2" とした。Description欄にはこのプロ ジェクトに関するメモを記すことができる。勿論、空白でも良い。今回作成予定の「リッ ジ導波路」は予め定義された雛形として用意されているので、これを用いることとする ため、Pre-definedにチェックを入れた。

🦽 Waveguide -	Greate Waveguide Project	
	reate Waveguide Project	
Г	Reject Name	
	W_InGaN-LD2	
	Description	
G		
An		
	How to create	
	© Pre-defined C. User-defined using pre-defined	
04		
A STATE		
	🖣 Back Next 🕨 Finish 🤣 Help 🗙 Cancel	

### 図D1-2.プロジェクト名の入力

WizardでNextをクリックすると図D1-3が現れる。導波路を構成する材料の選択が求められる。InGaN系は標準で用意している材料メニューにないので、このまま InP/InGaAs系を仮に選択したままで、Nextをクリックする。

注)半導体レーザでは発振波長が定まるのでその波長での屈折率を定数として定義すれば良い。構造定義と同時または構造定義後に屈折率を入力(修正を含めて)できる。

🍠 Waveguide –	· Select Material System
	Select Material System
	C Material Project C User Input Index Profile
	Select Material Type InP/InGaAsP
	Name       Selected Project Material         Imp_IncgaAsP       Imp_Strosgerg         InGaAsP Bandgap=1.0um       InGaAsP Bandgap=1.0um         InGaAsP Bandgap=1.1um       InGaAsP Bandgap=1.2um         InGaAsP Bandgap=1.2um       InGaAsP Bandgap=1.3um         InGaAsP Bandgap=1.4um       InGaAsP Bandgap=1.4um
	Description     InP material model based on     Broberg's paper in J. Appl. Phys. vol     55, No. 9, pp. 3376, 1984.
	🖣 Back Next 🕨 Finish 🥔 Help 🗡 Cancel

Nextをクリックすると、図D1-4のPre-defined (雛形)が開く。Select Waveguide Type のコンボボックスで解析しようとするタイプを選択する。今回の場合、"Ridge"を選ぶ。 構造は冒頭の表D1-1に記した。この構造は4nmの井戸層と10nmの障壁層からなるダ ブルQWである。テキスト同様にAlGaN/GaNのSL(スパーラティス)を等価的なバルク で置き換え、基板と12層からなる構造として作成した。そのため、層数(赤丸)は12とし た。解析対象の構造は左右対称であるとして、半分の領域を解析対象として選択し(青 丸)計算の効率化を図った。



Nextをクリックすると図D1-5が現れる。この段階では、基板と12層の構造からなる状態のみが表示されている。図D1-5の"Geometry"タブ(赤丸)を選択し、"Expression"の欄(赤四角)にµm単位でリッジ幅、メサ深さ、各層の厚さを入力する。参考にした文献ではリッジ幅とメサ深さの値が記載されていなかった。ここでは、前者を2.0µm、後者を0.65µmとして計算した。



図D1-5.層構造を反映しているが寸法や屈折率を定義する前の状態

"Geometry"で寸法入力が終わると、タブを図D1-6のように"Materials"(赤丸)に切り替 え、解析しようとする波長に対して各層の屈折率(赤四角)を入力する。屈折率の虚部 はロス(負)とゲイン(正)を示すが、今回の計算では全てゼロとした。屈折率入力中は 入力した値で層の濃淡が変化する。下図に示したように屈折率の高い領域は濃く、低 い領域は淡く表示される。



と、"Finish"(青 丸)をクリックす るとWizardが終 了する。

入力が終わる

8

Wizardが終了したときは、図D1-7となる。

この状態で"Geometry"タブで寸法、"Materials"タブで屈折率の修正を行なうことも可能。



図D1-7.Wizardが終了した画面

以上で、導波路形状と屈折率が定義されたことになる。ここからは、シミュレーションの ための設定に入る。図D1-7でシミュレーション実行(Run Simulation)ボタン(赤丸)をク リックする。解法設定の図D1-8のウインドウが開く。 9

## 波長は0.4µmで1点のみなので、赤四角のように設定する。オプション は"Simulation"を選択する。"Mesh Setting"(赤丸)を選択すると図D1-9のウ ンドウが開く。

🚳 Waveguide Solver Setting				
General Intermation   FD Mode Solver Setting				
<ul> <li>Simulation</li> </ul>		C Scanning		
Variables				
Name	Default Value	Start Value	End Value	No. of Points
	0.4	0.4	0.4	
			Structu	ure Check
Waveguide Type © Straight			Numerica FD Mode	al Solver : e Solver 🔍
C Bending R: 100	00		Mes	h Setting.
	l	<u>B</u> un	<u>C</u> lose	<i>.</i>

図D1-8. 解法設定画面

Y(横)方向とX(縦)方向のメッシュを設定する。材質境界を認識したマルチセクション のデフォルトメッシュを生成(赤丸)して、そのメッシュの2倍などのように"No of Meshes"をユーザが修正する。また、その右には、Uniform, Linear, Bilinearなど のメッシュタイプとタイプに対応した項比の設定ができる。

差分法で精度が良い解が得られ るには近接メッシュ間隔がアンバ ランスにならないことが重要なガ イドラインである。左右、上下で1 桁もメッシュ間隔が異なるような メッシュ配置は避けたい。 タブを切り替え(青丸)、X方向に も同様にメッシュを配置する(図 D1-10)。



図D1-9.Y(横)方向のメッシュ設定<sup>11</sup>

## 本例題では、この方向にQWを含むので、この部分を拡大するには"Zoom In" の機能(赤丸)を用いる。



図D1-10.X方向のメッシュ設定後の画面

Zoom Inしてマウスで拡大 したい領域を選択すると、 図D1-11のようになる。

この図から、4nmの井戸層、 が2つ、その両脇に10nm の障壁層が3つ存在して いることが確認できる。ま た、この領域にも適当本数 のメッシュが配置されてい ることがわかる。

図D1-10またはD1-11で "Close"を選択すると、図D1-8に戻る。"FD Mode Solver Setting"タブを選択すると図 D1-12となる。





図D1-12. FD Mode Solver Setting

🥵 W_In GaN-LD-Ridge	
Target: Field and Modal Parameters (Semi-vector and X	pol.)
Elapsed time: 00:00:04	
	▶ <u>B</u> esume
Current iteration progress:	Pause
Overall progress:	
	<u>Cancel</u>



図D1-15.モード計算終了のメッセージ

# 計算が正常に終了する と図D1-15の表示でOK (赤丸)をクリックする。

# 図D1-13.プログレッシブバー(X偏波のモード解析中)

🍜 W_In GaN-LD-Ridge	
Target: Field and Modal Parameters (Semi-vector and Y pol.)	1
Elapsed time: 00:00:25	
	▶ <u>R</u> esume
Current iteration progress:	Pause
Overall progress:	
	🔳 <u>C</u> ancel

図D1-14. プログレッシブバー (Y偏波のモード解析中)

計算が正常に終了すると下図に示すように、"View Simulation Results"のボタン (赤丸)が有効になる。このボタンをクリックすることでフィールド分布(図D1-17)を 表示させることができる。



図D1-16.モードの計算が終了したときのウインドウ表示

下図で"View Structure" (赤丸)をクリックすることで、計算され たフィールドと構造体(白線)を重ねて表示することができる。



【実習1終了】